



汕头华汕电子器件有限公司

NPN SILICON TRANSISTOR

H1008

对应国外型号
KSC1008

主要用途

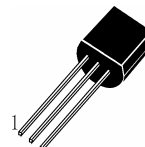
作低频放大。

极限值 ($T_a=25$)

T_{stg}	——贮存温度.....	-55~150
T_j	——结温.....	150
P_C	——集电极耗散功率.....	800mW
V_{CBO}	——集电极—基极电压.....	80V
V_{CEO}	——集电极—发射极电压.....	60V
V_{EBO}	——发射极—基极电压.....	8V
I_C	——集电极电流.....	700mA

外形图及引脚排列

TO-92



1—发射极, E
2—基 极, B
3—集电极, C

电参数 ($T_a=25$)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			0.1	μA	$V_{CB}=60V, I_E=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			0.1	μA	$V_{EB}=5V, I_C=0$
HFE	直流电流增益	40		400		$V_{CE}=2V, I_C=50mA$
$V_{CE(sat)}$	集电极—发射极饱和电压		0.2	0.4	V	$I_C=500mA, I_B=50mA$
$V_{BE(sat)}$	基极—发射极饱和电压		0.86	1.1	V	$I_C=500mA, I_B=50mA$
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	80			V	$I_C=100\mu A, I_E=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	60			V	$I_C=10mA, I_B=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	8			V	$I_E=10\mu A, I_C=0$
f_T	特征频率	30	50		MHz	$V_{CE}=10V, I_C=50mA$

分档及其标志

R

O

Y

GR

40—80

70—140

120—240

200—400